Nom:	Prénom :	Groupe:	
ECOLE POLYTECH	INIQUE UNIVERSITAIRE DE NI	CE SOPHIA-ANTIPOLIS	
Université Nice Sophia Antipolis	Cycle Initial Polytech Première Année Année scolaire 2013/2014	Note / 20	
École d'ingénieurs  POLYTECH' NIGE-SOPHIA	DS électronique analogique No3		

Mardi 6 Mai 2014 Durée : 1h30

- □ Cours et documents non autorisés.
- □ Calculatrice de type collège autorisée
- □ Vous répondrez directement sur cette feuille.
- □ Tout échange entre étudiants (gomme, stylo, réponses...) est interdit
- □ Vous devez :
  - indiquer votre nom et votre prénom.
  - éteindre votre téléphone portable (- 1 point par sonnerie).

## **RAPPELS:**

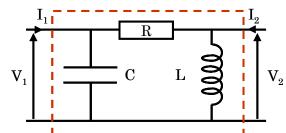
Impédance d'une capacité $C: 1/(jC\omega)$ $[\Omega]$	Impédance d'une bobine $L: jL\omega$ [ $\Omega$ ]
Filtre passe bas : $G(\omega) = \frac{H}{1 + j\omega RC} = \frac{H}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$	Filtre passe haut : $G(\omega) = \frac{H}{1 - j\frac{1}{\omega RC}} = \frac{H}{1 - j\frac{\omega_0}{\omega}}$
	$ \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \qquad \begin{cases} V_1 = Z_{11}.I_1 + Z_{12}.I_2 \\ V_2 = Z_{21}.I_1 + Z_{22}.I_2 \end{cases} $
	$ (I_1 - V_1, V_1 + V_1, V_2) $
matrice admittance $\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$	$ \begin{bmatrix} 12 \\ V_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = Y_{11}.V_1 + Y_{12}.V_2 \\ I_2 = Y_{21}.V_1 + Y_{22}.V_2 $
Gain en tension en représentation impédance*:	$A_{v} = \frac{V_{2}}{V_{1}} = \frac{Z_{21}}{Z_{11} + \frac{Z_{11}.Z_{22} - Z_{12}.Z_{21}}{X}}$

<sup>\*</sup> X représente l'impédance branchée en sortie du quadripôle.

# EXERCICE I : Quadripôles (6 pts)

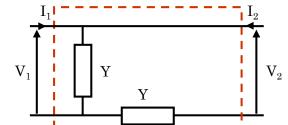
- 1
- I.1. Par la méthode de votre choix, déterminer les paramètres impédances de ce quadripôle :
- (0.25 pt)  $Z_{11} =$
- $V_1$  R R V
- (0.25 pt)  $Z_{12} =$
- (0.25 pt)  $Z_{21} =$
- (0.25 pt)  $Z_{22} =$

- 1
- I.2. Par la méthode de votre choix, déterminer les paramètres admittances de ce quadripôle :
- **(0.25 pt)**  $Y_{11} =$



- **(0.25 pt)**  $Y_{12} =$
- **(0.25 pt)**  $Y_{21} =$
- **(0.25 pt)**  $Y_{22} =$

- 1
- I.3. Par la méthode de votre choix, déterminer les paramètres admittances de ce quadripôle :
- **(0.25 pt)**  $Y_{11} =$



- **(0.25 pt)**  $Y_{12} =$
- **(0.25 pt)**  $Y_{21} =$
- (0.25 pt)  $Y_{22} =$

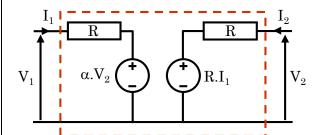
Brouillon

1

**I.4.** Par la méthode de votre choix, déterminer les paramètres impédances de ce quadripôle :

(0.25 pt)  $Z_{11} =$ 

(0.25 pt)  $Z_{12} =$ 

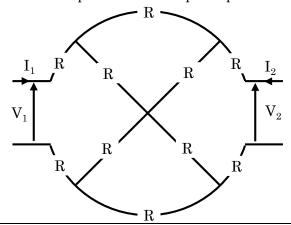


(0.25 pt)  $Z_{21} =$ 

(0.25 pt)  $Z_{22} =$ 

**I.5.** Par la méthode de votre choix, déterminer 2 des 4 paramètres impédances de ce quadripôle :

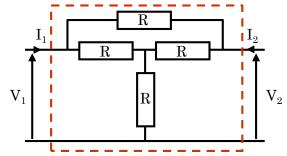
(0.5 pt)  $Z_{11} =$ 



(0.5 pt)  $Z_{12} =$ 

**I.6.** Par la méthode de votre choix, déterminer les paramètres impédances de ce quadripôle :

(0.25 pt)  $Z_{11} =$ 



(0.25 pt)  $Z_{12} =$ 

(0.25 pt)  $Z_{21} =$ 

(0.25 pt)  $Z_{22} =$ 

Brouillon

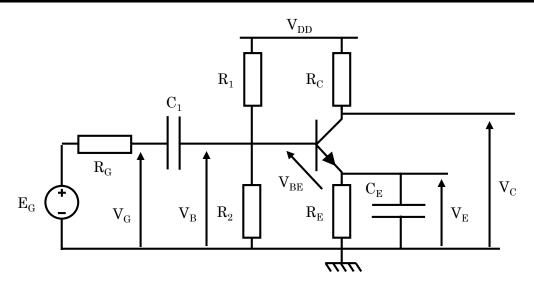


Figure II.1

Soit le circuit de la figure II.1. Le transistor a un gain en courant  $\beta$ , une tension de saturation  $V_{\text{CE}sat}$  ainsi qu'une résistance  $R_{\text{S}}$  et une tension  $V_{\text{S}}$  pour sa diode base-émetteur.  $h_{\text{oe}}$  sera négligée.

## II.1. Etude en statique du montage

- II.1.1. Dans quel régime se trouve le transistor pour pouvoir amplifier le signal E<sub>G</sub>(t)?
  - A Bloqué
  - B Linéaire
  - C Saturé
- II.1.2. Comment doit-on considérer les capacités en régime statique?
  - A Comme des courts-circuits
  - B Comme des circuits ouverts
  - C Comme des fils
  - D Comme des résistances
- II.1.3. Donner l'expression du courant I<sub>B0</sub> en fonction de V<sub>DD</sub>, R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>8</sub>, V<sub>8</sub>, R<sub>E</sub> et β. Vous pourrez vous aider d'un générateur de Thévenin équivalent si vous voulez.

 $I_{B0} =$ 

0.25

0.25

 $I_{\rm C0} =$ 

II.1.4. Donner l'expression de la tension  $V_{\text{CEO}}$  en fonction de  $V_{\text{DD}},\,R_{\text{C}},\,R_{\text{E}},\,I_{\text{B}}$  et  $\beta.$ 

0.5

 $V_{\rm CE0} =$ 

II.1.5. Comment doit être  $V_{CE}$  par rapport à  $V_{CEsat}$ ?

0.25

- $A \quad V_{\rm CE} < V_{\rm CEsat}$
- $B \quad V_{\rm CE} > V_{\rm CEsat}$
- $C \quad V_{\rm CE} = V_{\rm CEsat}$
- $D \quad V_{\rm CE} > V_{\rm DD}$

Brouillon

# II.2. Etude en régime dynamique du montage

Les capacités  $C_1$  et  $C_E$  seront considérées comme des courts-circuits. Pour simplifier les expressions, on posera  $R_e$  =  $R_1$  //  $R_2$  //  $R_S$ 

1

II.2.1 Donner le schéma en régime petit signal du schéma de la figure (II.1). Il faudra indiquer où se trouvent : la base, le collecteur, l'émetteur,  $i_b$ , et  $\beta.i_b$ .

1

II.2.2 Donner l'expression du gain en tension.

$$A_{V1} = \frac{v_c}{v_b} =$$

0.5

II.2.3 Donner l'expression du gain composite en tension.

$$A_{VG1} = \frac{v_c}{e_g} =$$

### II.3. Etude en régime dynamique du montage avec la capacité C1

La capacité  $C_E$  est considérée comme un court-circuit. Pour simplifier les expressions, on posera  $R_e$  =  $R_1$  //  $R_2$  //  $R_S$ 

## II.3.1. Quel est le rôle de la capacité C<sub>1</sub> (entourer la bonne réponse) ?

0.25

- A Augmenter le gain en alternatif en court-circuitant la résistance R2
- B Empêcher que la partie statique de E<sub>G</sub> modifie le point de polarisation du transistor.
- C Eviter l'échauffement du transistor
- D Court-circuiter la base pour laisser passer la partie alternative de Eg
- E Empêcher que la partie statique de  $V_{DD}$  modifie le point de polarisation du transistor.

### II.3.2. Pour le circuit, la capacité C1 représente un filtre :

0.25

- A Passe Bas
- B Passe Haut
- C Passe Calou

Brouillon	

II.3.3 Donner le schéma en régime petit signal du circuit de la figure (II.1). Il faudra indiquer où se trouvent : la base, le collecteur, l'émetteur,  $i_b$ , et  $\beta.i_b$ .

0,5

II.3.4. Déterminer l'expression du gain en tension

$$A_{VC1} = \frac{v_c}{v_g} =$$

0,5

II.3.5. Identifier alors l'expression de la fréquence du filtre, Fc1:

 $F_{C1} =$ 

0,5

II.3.6. On souhaite amplifier un signal audio dont les fréquences sont comprises entre  $20~\mathrm{Hz}$  et  $20~\mathrm{kHz}$ . Représenter l'allure du gain  $A_{\mathrm{VC1}}$  (question II.3.4.) sur la figure (II.2). Il faudra aussi positionner le gain  $A_{\mathrm{V1}}$  (question II.2.2.)

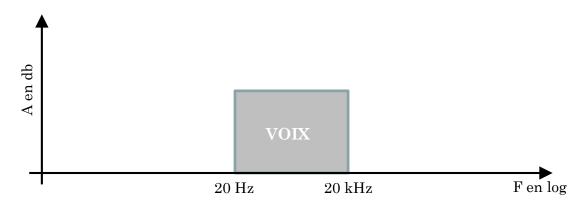


Figure II.2

### II.4. Etude en régime dynamique du montage avec la capacité CE

La capacité C<sub>1</sub> est considérée comme un court-circuit.

<b>11.4.1.</b> Quel est le role de la capacite $C_E$ ?	
--	--

0.25

- A) Augmenter la valeur de la résistance R<sub>E</sub>.
- B) Empêcher la tension  $V_{\text{E}}$  de varier et ainsi augmenter la valeur du gain  $A_{V1} = v_{\text{d}}/v_{\text{b}}$ .
- C) Stabiliser thermiquement le transistor.
- D) Augmenter l'effet de la capacité C1

II.4.2. Pour V<sub>G</sub> et E<sub>G</sub>, la capacité C<sub>E</sub> forme un filtre ?

0.25

- A) Passe haut.
- B) Passe bas.

Brouillon

C) Passe Us Duriusculus

II.4.3. Donner le schéma en régime petit signal du circuit de la figure (II.1). Il faudra indiquer où se trouvent : la base, le collecteur, l'émetteur,  $i_b$ , et  $\beta.i_b$ .

1

II.4.4. Si on suppose que la capacité C<sub>E</sub> est un circuit ouvert (donc en basse fréquence), donner l'expression du gain en tension.

$$A_{V2} = \frac{v_c}{v_b} =$$



II.4.5. Comparer les gains Av<sub>1</sub> (question II.2.2.) et Av<sub>2</sub> (question II.4.4).

A) 
$$A_{V1} < A_{V2}$$

B) 
$$A_{V1} > A_{V2}$$

C) 
$$A_{V1} = A_{V2}$$



II.4.6. En tenant compte de C<sub>E</sub>, quelle est l'expression du gain en tension. <u>Attention, ce gain ne correspond ni à un passe bas, ni à un passe haut comme défini en rappel.</u>

$$A_{VCE_2} = \frac{v_c}{v_b} =$$

0.25

II.4.7. Vers quelle expression tend le gain du montage lorsque la fréquence tend vers 0.

$$A_{\text{VCE}_2}|_{F\to 0} =$$

0.25

II.4.8. Vers quelle expression tend le gain du montage lorsque la fréquence tend vers l'infini.

$$A_{\text{VCE}_{-2}}\big|_{F\to\infty} =$$

II.4.9. On souhaite amplifier un signal audio dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Représenter l'allure du gain A<sub>VCE\_2</sub> (question II.4.6.) sur la figure (II.3). Il faudra aussi positionner les gains A<sub>V2</sub> (II.4.4) et A<sub>V1</sub> (question II.2.2.)



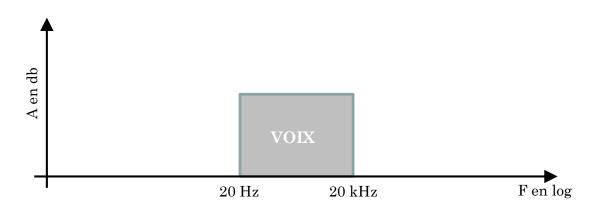


Figure II.3

Brouillon		

# EXERCICE III: Amplificateur et quadripôle (2 pts)

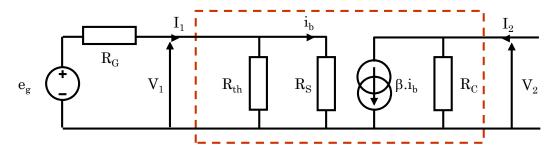


Figure III.1

Soit, à la figure (III.1), le schéma petit signal d'un amplificateur

III.1. Par la méthode de votre choix, déterminer les paramètres impédances du quadripôle amplificateur.

$$Z_{11} = Z_{12} =$$

$$\mathbf{Z}_{21}$$
 =  $\mathbf{Z}_{22}$  =

1 III.2. En utilisant les rappels, donner l'expression du gain en tension :

$$A_{V} = \frac{V_2}{V_1} =$$

1.	

# EXERCICE IV : Amplificateur et quadripôle (2 pts bonus)

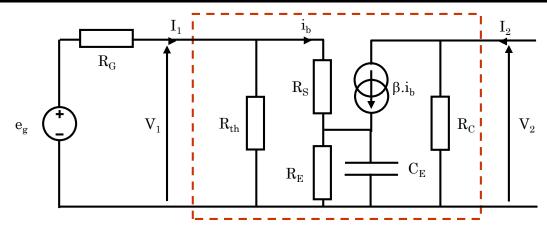


Figure IV.1

Soit, à la figure (IV.1), le schéma petit signal d'un amplificateur

IV.1. Par la méthode de votre choix, déterminer les paramètres impédances du quadripôle amplificateur. Pour simplifier, vous pouvez utiliser la notation //

1 bonus

 $Z_{11} =$ 

$$Z_{12} =$$

 $Z_{21} =$ 

$$Z_{22} =$$

IV.2. En utilisant les rappels, donner l'expression du gain en tension :

1 bonus

$$A_{V} = \frac{V_2}{V_1} =$$

Brouillon				

Brouillon	